文章编号: 1001 3806(2004) 04 0379 04

双包层 Er³⁺ / Yb³⁺ 共掺光纤放大器粒子数特性分析

庄茂录,赵尚弘,董淑福,马丽华 (**空军工程大学 电讯工程学院,西安** 710077)

摘要:基于速率方程和光传输方程,对双包层 Er³⁺ / Yb³⁺ 共掺光纤放大器的计算模型进行了讨论,并利用数值 模拟结果对 980nm 激光抽运双包层 Er³⁺ / Yb³⁺ 共掺光纤放大器 Er³⁺ 上能级粒子数的分布特性进行了分析。分别给 出了正向抽运和反向抽运条件下, Er³⁺ 归一化上能级粒子数分布曲线。利用上能级粒子数沿光纤的分布曲线解释 了信号光沿光纤的分布规律。

Numerical analysis of the population distribution characteristics in Er^{3+} / Yb³⁺ co doped double clad fiber amplifiers

ZH UANG Mao-lu, ZHAO Shang-hong, DONG Shu-fu, MA Li-hua

(Institute of Telecommunication Engineering, Air Force Engineering, University, Xi an 710077, China)

Abstract: Based on the rate equations and light propagation equations the model of $Er^{3+} / Yb^{3+} c\sigma$ doped double dad fiber amplifiers has been discussed, and the population distribution characteristics of Er^{3+} upper level in $Er^{3+} / Yb^{3+} c\sigma$ doped double dad fiber amplifier pumped at 980nm bands have been analyzed by using the results of numerical simulation. The normalized population distribution curves of Er^{3+} upper level have been obtained under two different pump schemes, namely $c\sigma$ and courter propagations. The distribution characteristic of signal has also been analyzed by using the normalized population distribution curves of Er^{3+} upper level.

Key words: fiber amplifiers; double clad fiber; abunr ytterbium or doped; population distribution

引 言

在双包层 Er³⁺ /Yb³⁺ 共掺光纤放大器中,由于 包层抽运技术的运用,克服了光纤放大器抽运耦合 效率低的瓶颈限制^[1];而纤芯中镱离子的加入,不但 有效地抑制了高浓度铒离子之间的能量上转换过 程^[2],提高了能量转换效率,而且使铒镱共掺光纤的 吸收谱变得相当宽(800m~1100nm)^[3],降低了对 抽运光模式的要求,使高功率、高转换效率光纤放大 器成为现实。在掺稀土元素光纤放大器中,上能级 粒子数的分布特性决定了信号光的增益,而产生的 自发辐射决定了放大器的噪声特性。因此,掺稀土 元素光纤放大器的特性与上能级粒子数的分布是密 切相关的。 笔者从速率方程和功率传输方程出发,对双包 层 Er³⁺ / Yb³⁺ 共掺光纤放大器理论模型进行了讨 论,并对双包层 Er³⁺ / Yb³⁺ 共掺光纤放大器进行数 值模拟,对正向抽运和反向抽运条件下 Er³⁺ 上能级 粒子数分布特性进行了比较分析。

双包层 Er³⁺ / Yb³⁺ 共掺光纤放大器理论 模型

Er³⁺ / Yb³⁺ 共掺光纤中原子的能级及能量传递 如图 1 所示^[4]。



Fig. 1 Energy level diagram of the Er Yb co doped system

作者简介: 庄茂录(1971), 男, 硕士研究生, 主要从事光 通信器件研究。

E-mail: zmlgh@ sohu.com

收稿日期: 2003 07 09; 收到修改稿日期: 2003 10 09

图中, Er³⁺ 的⁴I_{15/2}, ⁴I_{13/2}, ⁴I_{11/2}和⁴I_{9/2}上的粒子数 密度分别用 N₁, N₂, N₃ 和 N₄ 表示, Yb³⁺ 的²F_{5/2} 和²F_{7/2}上的粒子数密度分别用 N₆, N₅ 表示。通过 对 Er³⁺, Yb³⁺ 粒子跃迁状况的分析, 可得出以下粒 子数稳态时的速率方程:

$$\frac{\partial N_4}{\partial t} = -\frac{N_4}{\tau_{43}} + C_{\rm up} N_2^2 = 0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial N_3}{\partial t} = W_{\rm B}N_1 - \frac{N_3}{\tau_{\mathfrak{D}}} + \frac{N_4}{\tau_{43}} + C_{\alpha}N_1N_6 = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial N_2}{\partial t} = W_{12}N_1 - W_{21}N_2 + \frac{N_3}{\tau_{32}} - \frac{N_2}{\tau_{21}} - 2C_{\rm up}N_2^2 = 0(3)$$

$$N_{\rm Er} = N_1 + N_2 + N_3 + N_4 \tag{4}$$

$$\frac{\partial N_6}{\partial t} = W_{56}N_5 - \frac{N_6}{\tau_{65}} - W_{65}N_6 - C_{\alpha}N_1N_6 = 0 \quad (5)$$

$$N_{\rm Yb} = N_5 + N_6$$
 (6)

式中, W_{ij} 表示能级 i 和j 之间的受激吸收或受激辐 射跃迁的几率, T_{21} 和 T_{65} 表示 $^{4}I_{13/2}$ 和 $^{2}F_{5/2}$ 能级上粒子 自发辐射的寿命, 二次项系数 C_{up} 表示从 $^{4}I_{13/2}$ 态分 别到 $^{4}I_{15/2}$ 态和 $^{4}I_{9/2}$ 态的能量上转换过程, 交叉弛豫 系数 C_{cr} 表示从 Yb³⁺ 到 Er³⁺ 的能量传递过程。

在 Er^{3+} / Yb³⁺ 共掺光纤中,由于镱离子的加入, 有效地抑制了高浓度铒离子之间的能量上转换过 程^[3],所以,在实际的计算过程中可以不考虑铒离子 的能量上转换过程^[5]。又由于 Er^{3+} 的⁴I_{11/2}和⁴I_{9/2}能 级上粒子寿命远小于⁴I_{13/2}能级上粒子寿命 $T_{43} \approx$ 1ns, $T_{32} \approx 0.1 \mu$ s, $T_{21} \approx 11 \mathrm{ms}^{[6,7]}$),故(1) 式 (4) 式可 简化为:

$$\frac{\partial N_2}{\partial t} = W_{12}N_1 - W_{21}N_2 - \frac{N_2}{\tau_{21}} + W_{13}N_1 + C_{\alpha}N_1N_6 = 0(7)$$

$$N_{\rm Er} = N_1 + N_2$$
 (8)

W12和 W21分别为信号光的受激吸收、受激辐射跃迁
 几率, W13, W56和 W65分别为抽运光的受激吸收、受激辐射跃迁几率, 它们由下列式子给出:

$$W_{12}(r, \theta, z) = \frac{\sigma_{12}(v_{s})}{hv_{s}}I_{s}(r, \theta, z, v_{s}) + \sum_{j=1}^{M}\sigma_{12}(\gamma) \frac{I_{ASE+}(r, \theta, z, v_{j}) + I_{ASE-}(r, \theta, z, v_{j})}{hv_{j}} \qquad (9)$$

$$W_{21}(r, \theta, z) = \frac{\sigma_{21}(v_{s})}{hv_{s}}I_{s}(r, \theta, z, v_{s}) + \sum_{j=1}^{M}\sigma_{21}(\gamma) \frac{I_{ASE+}(r, \theta, z, v_{j}) + I_{ASE-}(r, \theta, z, v_{j})}{hv_{j}} \qquad (10)$$

$$W_{13}(r, \theta, z) = \frac{\sigma_{13}(v_p)}{hv_p} I_p(r, \theta, z, v_p) \qquad (11)$$

$$W_{56}(r, \theta, z) = \frac{\sigma_{56}(v_{\rm p})}{hv_{\rm p}} I_{\rm p}(r, \theta, z, v_{\rm p})$$
 (12)

$$W_{\mathfrak{G}}(r, \theta, z) = \frac{\sigma_{65}(\mathcal{V}_{p})}{h\mathcal{V}_{p}}I_{p}(r, \theta, z, \mathcal{V}_{p}) \qquad (13)$$

抽运光、信号光和 ASE 的功率传输方程为^[8]:

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{p}}(z, \mathcal{V}_{\mathrm{p}})}{\mathrm{d}z} = - \mathcal{V}_{\mathrm{p}}(z, \mathcal{V}_{\mathrm{p}})P_{\mathrm{p}}(z, \mathcal{V}_{\mathrm{p}}) - \alpha_{\mathrm{p}}P_{\mathrm{p}}[z, \mathcal{V}_{\mathrm{p}}] \quad (14)$$

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{s}}(z, \mathcal{V}_{\mathrm{s}})}{\mathrm{d}z} = \left[\mathcal{V}_{21}(z, \mathcal{V}_{\mathrm{s}}) - \mathcal{V}_{12}(z, \mathcal{V}_{\mathrm{s}}) \right] P_{\mathrm{s}}(z, \mathcal{V}_{\mathrm{s}}) - \alpha_{\mathrm{s}} P_{\mathrm{s}}(z, \mathcal{V}_{\mathrm{s}}) \left(15 \right)$$

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{ASE}}^{\pm}(z, \mathcal{V}_{\mathrm{k}})}{\mathrm{d}z} = \pm mh\mathcal{V}_{\mathrm{k}}\Delta\mathcal{V}_{\mathrm{k}} \, \mathbf{Y}_{21}(z, \mathcal{V}_{\mathrm{k}}) \pm \left[\mathbf{Y}_{21}(z, \mathcal{V}_{\mathrm{k}}) - \mathbf{Y}_{12}(z, \mathcal{V}_{\mathrm{k}}) \right] P_{\mathrm{ASE}}^{\pm}(z, \mathcal{V}_{\mathrm{k}}) \quad (16)$$

$$\vec{\mathbf{x}} \mathbf{\hat{\mu}}, \quad \mathbf{\hat{y}}_{p}(z, \mathbf{\hat{v}}_{p}) = \iint_{A} \left[\mathbf{\sigma}_{13}(\mathbf{\hat{v}}_{p})N_{1}(r, \theta, z) + \mathbf{\sigma}_{56}(\mathbf{\hat{v}}_{p}) \times N_{5}(r, \theta, z) - \mathbf{\sigma}_{65}(\mathbf{\hat{v}}_{p})N_{6}(r, \theta, z) \right] \mathbf{\hat{\psi}}_{p}(r, \theta) r dr d\theta,$$

$$\mathbf{\hat{y}}_{12}(z, \mathbf{\hat{v}}_{i}) = \iint_{A} \left[\mathbf{\sigma}_{12}(\mathbf{\hat{v}}_{i})N_{1}(r, \theta, z) \mathbf{\hat{\psi}}_{s}(r, \theta) r dr d\theta, \right]$$

$$\mathbf{\hat{y}}_{21}(z, \mathbf{\hat{v}}_{i}) = \iint_{A} \left(\mathbf{\hat{v}}_{21}(\mathbf{\hat{v}}_{i})N_{2}(r, \theta, z) \mathbf{\hat{\psi}}_{s}(r, \theta) r dr d\theta, \right]$$

其中, $\sigma_{12}(\nu)$, $\sigma_{21}(\nu)$, $\sigma_{13}(\nu)$, $\sigma_{56}(\nu)$ 和 $\sigma_{65}(\nu)$ 分别 是与频率有关的 Er^{3+} , Yb^{3+} 的吸收和发射截面面 积, h 是普朗克常数, v_s , v_p 分别是激光和抽运光波 长, A 是纤芯截面积。 $I_p(r, \theta, z, V_p)$, $I_s(r, \theta, z, V_s)$ 分别为抽运光和信号光的光强, $I_{ASE+}(r, \theta, z, V_j)$, $I_{ASE-}(r, \theta, z, V_j)$ 分别为正向传输和反向传输的自 发辐射光的光强, $I(r, \theta, z, V) = P(z, V) \Phi(r, \theta)$, P_s (z), $P_p(z)$ 分别是激光功率和抽运光功率, $\Phi_p(r, \theta)$, $\Phi_s(r, \theta)$ 分别为抽运光和信号光的归一化光强 分布函数。由于 Yb^{3+} 亚稳态能级的粒子数相对于 基级的粒子数要少得多($N_6 = N_{Yb}$ 的比例一般小于 10%)^[9], 所以, 可以忽略 Yb^{3+} 波段附近的自发辐射 光, 抽运光受激吸收和受激发射几率 W_{13}, W_{56}, W_{65} 中可以不考虑自发辐射光的光强。

(14) 式~(16) 式在正向抽运情况下的边界条件 为^[8,10]:

$$\begin{cases}
P_{p}(0) = P_{p}^{in} \\
P_{s}(0) = P_{s}^{in} \\
P_{ASE}^{+}(z = 0, \lambda_{k}) = P_{ASE}^{-}(z = L, \lambda_{k}) = \\
0(j = 1, M)
\end{cases}$$
(17)

上述方程的数值计算过程较为复杂,为了简化计算, 文献[9]中引入了重叠因子模型 Γ。重叠因子模型 的引入,有效地降低 Er³⁺ / Yb³⁺ 共掺光纤放大器数 值分析计算过程的复杂度,并对 Er³⁺ / Yb³⁺ 共掺光 纤放大器的增益和噪声等特性进行了合理的解释。

但是, 文献[9] 中引入的重叠因子源自掺铒光纤 放大器^[11], 它是通过对单包层掺铒光纤放大器简化

的粒子数速率方程沿光纤径向积分得到,对只掺杂 一种稀土元素的光纤放大器比较适合, 如掺 Er³⁺, 掺 Yb^{3+} 等光纤放大器。但对于双包层 Er^{3+} / Yb^{3+} 共 掺光纤放大器并不准确. 特别是无法准确反映上能 级粒子数沿光纤径向、轴向分布情况。首先,双包层 Er³⁺ / Yb³⁺ 共掺光纤放大器中能量转换过程要比掺 Er^{3+} 光 纤放 大 器复 杂得 多, 存 在 Yb(${}^{2}F_{5/2}$) + Er (⁴I15/2) [→] Yb(²F7/2) + Er(⁴I11/2) 能量传递的交叉弛豫 过程: 其次, 在掺铒光纤放大器中, 抽运光要求是单 模的、只需考虑单模抽运光在纤芯中传输。而双包 层Er³⁺ /Yb³⁺ 共掺光纤放大器中, 抽运光可以多模 的,在内包层和纤芯中同时传输,在内包层中传输的 多模抽运光反复穿越纤芯、被纤芯中掺杂的 Er³⁺、 Yb³⁺ 吸收。再次,在内包层截面上传输的多模抽运 光光场近似于均匀分布,而在纤芯截面中传输的信 号光光场近似于高斯分布, Er³⁺ 上能级粒子数并不 是均匀分布(见下面的数值分析)。通过对双包层 Er³⁺ / Yb³⁺ 共掺光纤放大器稳态时粒子数方程进行 径向积分并不能得到类似于掺铒光纤放大器中简化 计算复杂度的重叠因子 □。所以,在数值分析中,没 有采用简化的重叠因子模型。

2 数值分析

由于抽运光是多模的, 内包层截面积远大于纤 芯截面积, 可以假定抽运光在光纤内包层径向服从 均匀分布, 纤芯中传输的抽运光功率与总的抽运功 率的比值近似为纤芯截面积与内包层截面积之比。 基模传输的信号光光场分布函数采用高斯分布近 似。抽运光波长选取为 980mm, 信号光波长选取为 1550mm, 为便于计算只考虑信号光波长处的放大的 自发辐射(ASE) 噪声。

以加拿大国家光学研究所(NO) 生产的 EY801 双包层 Er³⁺ /Yb³⁺ 共掺光纤为增益介质, 结合边界 条件(17) 式, 运用 MATLAB 对上述方程进行数值求 解。该光纤的纤芯直径 4. 6μm, 纤芯数值孔径0. 18; 内包 层横截面为正六边形, 平行边距离(200±10) μm; 通过查阅光纤参数表单并参考有关文献^[2,6,7], 进行数值模拟的有关参数取值见表 1。

Table 1 Parameters for Er^{3+} / Yb^{3+} co doped double clad fiber

parameter	value
Er^{3+} concentration, N_{Er}	4. 8 × 10^{25} ions/m ³
${ m Yb}^{3+}$ concentration, $N_{ m Yb}$	5. 0×10^{26} ions/m ³

continue		
parameter	value	
Er^{3+} emission cross section, σ_{21}	$3.395 \times 10^{-25} \text{m}^2$	
${\rm Er}^{3*}$ absorption cross section, $\sigma^{}_{12}$	$2.75 \times 10^{-25} \text{m}^2$	
${\rm Er}^{3*}$ absorption cross section, $\sigma^{}_{13}$	2. $0 \times 10^{-25} \text{m}^2$	
$\rm Yb^{3+}$ emission cross section, $\sigma^{}_{65}$	5. $0 \times 10^{-25} \text{m}^2$	
$\rm Yb^{3+}$ absorption cross section, $\sigma^{}_{56}$	2. 5 × 10 ^{- 25} m ²	
${\rm Er}^{3+}$ emission lifetime, ${ au}_{2l}$	1 lms	
${\rm Yb^{3+}}$ emission lifetime, $\tau_{\rm 65}$	1. 5ms	
$\rm Yb^{3+}$ - to $\rm Er^{3+}$ cross-relaxation coefficient, $C_{\rm cr}$	2. $0202 \times 10^{-22} \text{ m}^3/\text{ s}$	
background losses for 980nm, $\alpha_{\rm p}$	3. $4538 \times 10^{-3} \text{m}^{-1}$	
background losses for 1550nm, $\alpha_{\rm s}$	3. $4538 \times 10^{-3} \text{m}^{-1}$	

2.1 正向抽运 首先对正向抽运条件下, Er³⁺ 上能级粒子数沿 光纤径向、轴向分布情况进行数值模拟, 如图 2 所 示。抽运功率 P₁= 1W, 信号功率 P₃= 1µW, 光纤长 度 L= 8m₆



Fig. 2 Spatial distribution of normalized population of upper level as a function of normalized core radius and fiber length

从图中可以明显看出, Er³⁺ 上能级粒子数沿光 纤径向分布是不均匀的。越接近于纤芯中心处, 上 能级粒子数越低, 越接近于纤芯边缘, 上能级粒子数 越高。这是由于越接近于纤芯中心处, 信号光强越 大, 使处于粒子数反转状态的上能级粒子通过受激 辐射方式迅速弛豫到下能级, 进而对信号光进行放 大; 越接近于纤芯边缘处, 信号光光强越弱, 处于粒 子数反转状态的上能级粒子没有充分通过受激辐射 方式迅速弛豫到下能级, 而是通过自发辐射方式弛 豫到下能级, 产生自发辐射。

图 3 是通过对上能级粒子数沿光纤径向积分得 到归一化上能级粒子数沿光纤长度的分布曲线。图 4 是信号光、正反向 ASE 沿光纤轴向的分布曲线。

对比图 3、图 4 可以看出,随着上能级粒子数的 增大,信号光功率的斜率逐步变大,信号光迅速放



Fig. 3 Normalized population of upper level as a function of fiber length



Fig. 4 Signal and ASE power as a function of fiber length

大,在上能级粒子数达到峰值点时,信号光功率的斜率值达到最大;随着上能级粒子数的减小,信号光虽然继续得到放大,但信号光上升的斜率值逐步减小, 信号光放大的趋势趋于平稳。当上能级粒子数达到 反转阈值(N₂=(σ₁₂/ σ₂₁)N₁,不考虑信号光背景损 耗)时,信号光功率达到最大值。随着上能级粒子数 进一步减小,信号光将逐步衰减。可见,从上能级粒 子数沿光纤的分布曲线可以对信号光沿光纤的分布 情况作出准确的解释。

2.2 反向抽运

图 5、图 6、图 7分别是反向抽运条件下, Er³⁺上 能级粒子数沿光纤径向和轴向的分布曲线、Er³⁺上 能级粒子数沿光纤长度的分布曲线、信号光和放大 的自发辐射光沿光纤长度的分布曲线。分析中, 抽 运功率、信号功率及光纤长度同 2.1 节。

由图 5~ 图 7 可以得到与正向抽运条件下相类 似的结论。但对比图 2、图 5 和图 3、图 7, 可以观察 到, Er³⁺ 上能级粒子数分布有所不同。在信号注入 端(*z* = 0), 反向抽运条件的上能级粒子数小于正向 抽运条件下的上能级粒子数。这是因为抽运光反向 注入(*z* = *L*), 抽运光传输到信号光注入端(*z* = 0) 处, 抽运光相对较弱, 通过受激吸收激发到上能级的 粒子数相对较少, 在信号光的作用下, 通过受激辐射 方式迅速跃迁到下能级, 实现对信号光的放大。接



Fig. 5 Spatial distribution of normalized population of upper level as a function of normalized core radius and fiber length



fiber position/m Fig. 7 Signal and ASE power as a function of fiber length

近光纤末端处,虽然抽运光较强,通过受激吸收激发 到上能级的粒子数较多,但此时信号光经过逐步放 大,在接近光纤末端,信号光光强较大,使更多的上 能级粒子通过受激辐射方式跃迁到下能级,所以在 稳态情况下,接近光纤末端处,上能级粒子数仍趋于 逐渐减少,但信号光仍得到进一步放大。这也说明 了为什么在相同情况下,反向抽运的信号光增益值 要大于正向抽运的信号光增益值。

3 结 论

-60L

通过数值模拟,对 Er³⁺ / Yb³⁺ 共掺双包层光纤 放大器的 Er³⁺ 上能级粒子数分布特性进行了分析, 可以得出以下结论: (1) Er³⁺ 上能级粒子数沿光纤 (下转第409页)



Fig. 3 Gray scale masks of some binary optical elements a —two levels mask of blazed grating b—eight levels mask of blazed grating c—two levels mask of Fresnel lens d—eight levels mask of Fresnel lens e—two levels mask of 2×2 Fresnel lens array f—eight levels mask of 2 × 2 Fresnel lens array

的二元光学灰度掩模是 8 个灰度级别的。灰度级别 越高, 器件的衍射效率也越高, 但相应的制作难 度也加大; 因为二元掩模便于利用常规的大规模集

(上接第382页)

的径向分布并不是均匀分布, 越接近天纤芯中心处, 上能级粒子数越低, 越接近于纤芯边缘, 上能级粒子 数越高; (2) Er³⁺ 上能级粒子数沿光纤长度分布有一 个由低到高, 再由高到低的过程; (3) 在 Er³⁺ 上能级 粒子数达到峰值点处, 信号光放大的斜率值最大; (4) 正向泵浦条件与反向泵浦条件下, Er³⁺ 上能级粒 子数沿光纤的分布并不相同。

参考文献

- DOMINIC V, MacCORMACK S, WAARTS R *et al.* 110W fibre laser
 [J]. Electron Lett, 1999, 35(14): 1158~ 1160.
- [2] FEDERIGHI M, PASQUALE F D. The effect of pair induced energy transfer on the performance of silica waveguide amplifiers with high Er³⁺ /Yb³⁺ concentrations [J]. IEEE Photon Technol Lett, 1995, 7 (3): 303~ 305.
- [3] MINELLY J D, BARNE W L, LAMING R I *et al*. Diode array pumping of Er³⁺ /Yb³⁺ cordoped fiber lasers and amplifiers [J]. IEEE Photon Technol Lett, 1993, 5(3): 303~ 310.

成电路技术进行加工,故开始所制作的二元光学器件一般都是两个台阶的,如达蔓光栅等。

5 结束语

基于空间光调制器的灰度掩模制作方法在整个 的灰度掩模法中是一个较新的方法,研究的空间还 很大,比如说将其同激光直写联系起来,就具有不少 的吸引力。随着这一方法的进一步推广,相信其会 具有更加宽广的应用前景。

参考文献

- [1] 金国藩, 严瑛白, 邬敏贤 *et al*. 二元光学 [M]. 北京: 国防工业 出版社, 1998.298~335.
- [2] MICHAEL R W, SU H. Laser direct write gray level mask and one step etching for diffractive microlens fabrication [J]. Appl Opt, 1998, 37 (32):7568~ 7576.
- [3] REIMER K, QUENZER H J, Micro optic fabrication using one level gray tone lithography (1) SPIE, 1997, 3008: 279~ 288.
- [4] DONALD C O, WILLE S R. Gray scale masks for diffractive optics fabrication: II Spanally filtered halftone screens [J]. Appl Opt, 1995, 34(32): 7518- 7526.
- [5] 颜树华 戴一帆,吕海宝 et al.基于空间光调制器的灰度掩模 制作系统 [J].中国激光,2004,31(1):45~47.
- [6] 章毓晋.图像工程(上册) 图像处理和分析 [M].北京:清华 大学出版社, 1999.43~50.
 - 吴若薇. 制版感光材料 [M]. 北京: 印刷工业出版社, 1989. 179 ~ 217, 235~ 242.
- [4] TACCHEO S, LAPORTA P, LONGHI S *et al*. Diode pumped bulk er biumr ytterbium lasers [J]. Appl Phys, 1996, B63: 425~ 436.
- [5] TANGUY E, LARAT C, POCHOLLE J P. Modelling of the erbium yt terbium laser[J]. Opt Commun, 1998, 153: 172~ 183.
- [7] SHOOSHTARI A, MESHKINFAM P, TOUAM T *et al*. Ion- exchanged Er/Yb phosphate glass waveguide amplifiers and lasers [J]. Opt Engrg, 1998, 37(4): 1188~ 1192.
- [8] KARÜSEK M. Optimum design of Er³⁺- Yb³⁺ co doped fibers for large signal high pump power applications [J]. IEEE J Q E, 1997, 33(10): 1699~ 1705.
- [9] ACHTENHAGEN M, BEESON R J, PAN F et al. Gain and noise in yt terbium sensitized erbium doped fiber amplifiers: measurements and simulations [J]. IEEE J Lightwave Technol, 2001, 19 (10): 1521~ 1526.
- [10] PEDERSEN B, BJAKLEV A. The design of erbium doped fiber amplifiers [J]. IEEE J Lightwave Technol, 1991, 9(9):1105~1112.
- [11] GILES C R, DESIRVIRE E. Modeling erbium doped fiber amplifiers
 [J]. EEE J Lightwave Technol, 1991, 9(2):271~283.